











	<h2 style="color: #E67E22;">FCP190N65F</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FCP190N65F
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220-3
	Datenblätter:  FCP190N65F.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 31154 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCP190N65F
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	31154 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 2mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	FRFET®, SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3225pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 20.6A (Tc) 208W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.6A (Tc)

FCP190N65F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP190N65F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP190N65F AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCP190N65F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP190N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p>FCP190N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p>FCP1913H104G Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 2% 50VDC 1913</p>	 <p>FCP1913H104G-E3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 2% 50VDC 1913</p>
 <p>FCP190N65F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220-3</p>	 <p>FCP190N60-GF102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCP190N60_GF102 Fairchild/ON Semiconductor FCP190N60_GF102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FCP190N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 17A TO220-3</p>

FCP190N65F Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCP190N65F AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCP190N65F Datenblatt	FCP190N65F-Datenblätter	FCP190N65F PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP190N65F
FCP190N65F Electronic	FCP190N65F-Komponenten	FCP190N65F-Verteiler	FCP190N65F-Bild	FCP190N65F-Teil
FCP190N65F Preis	FCP190N65F Hersteller	FCP190N65F Bild	FCP190N65F Aktie	FCP190N65F Inventar
FCP190N65F Neu	FCP190N65F Original	FCP190N65F garantiert	FCP190N65F RFQ	FCP190N65F Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited